

论文

MCP中单通道电子倍增参数的Monte Carlo模拟计算

韦亚一

中国科学院电子学研究所 北京 100080

收稿日期 1990-11-8 修回日期 1991-2-26 网络版发布日期 2009-9-25 接受日期

摘要

本文用Monte Carlo方法对电子在MCP单通道中传输,碰撞和次级发射的整个过程进行了模拟。给出了MCP中次级电子能量分布表达式。计算了MCP中单通道电子倍增的有关参数,并对比实验数据讨论了模型及其结果的合理性。

关键词 [微通道板](#) [Monte Carlo方法](#) [次级电子发射](#) [电子倍增](#)

分类号

MONTE CARLO SIMULATION AND COMPUTATION OF SINGLE CHANNEL MULTIPLYING PARAMETERS IN MCP

Wei Yayi

Institute of Electronics Academia Sinica Beijing 100080

Abstract

Monte Carlo method is used to simulate the whole courses of electronic transportation, collision and secondary emission in a single channel of MCP. The energy distribution formula of secondary electron of MCP is derived. Each parameter of a single channel in MCP is calculated and discussed.

Key words [MCP \(microchannel plate\)](#) [Monte Carlo method](#) [Secondary electron emission](#) [Electron multiplying](#)

DOI:

通讯作者

作者个人主页 [韦亚一](#)

扩展功能

本文信息

▶ [Supporting info](#)

▶ [PDF\(787KB\)](#)

▶ [\[HTML全文\]\(OKB\)](#)

▶ [参考文献\[PDF\]](#)

▶ [参考文献](#)

服务与反馈

▶ [把本文推荐给朋友](#)

▶ [加入我的书架](#)

▶ [加入引用管理器](#)

▶ [复制索引](#)

▶ [Email Alert](#)

▶ [文章反馈](#)

▶ [浏览反馈信息](#)

相关信息

▶ [本刊中包含“微通道板”的相关文章](#)

▶ 本文作者相关文章

· [韦亚一](#)